



## 計畫緣起

現有的「減法」加工技術中，雷射與機械有深度限制(深寬比不足 10)，半導體業的蝕刻製程有材料種類限制且成本高，亦有嚴重化學汙染。

我們正在開發一種利用電漿來進行的純物理蝕刻技術(含設備與方法)。理論上能在機械、雷射、半導體蝕刻技術無法辦到的加工領域(例如陶瓷材料高深寬比鑽孔)開創新市場。也因為製程無毒，期望能跨足生醫產品的加工。

## 計畫目標

開發一種利用電漿來進行的純物理蝕刻技術(含設備與方法)。理論上能在機械、雷射、半導體蝕刻技術無法辦到的加工領域(例如陶瓷材料高深寬比鑽孔)開創新市場。也因為製程無毒，期望能跨足生醫產品的加工。

## 產品介紹

以特殊設計的硬體與製程，實現以電將進行純物理蝕刻。有電子束、離子束、雷射能隊幾乎任意材料加工的特性，但又有半導體蝕刻製程的大規模同步加工特性。

## 產品照片

